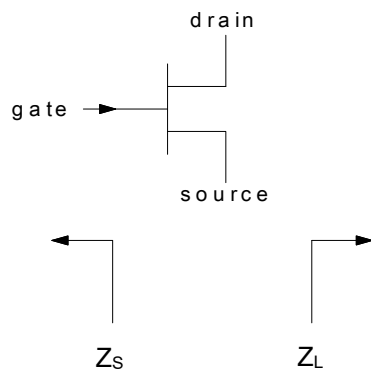


5. 阻抗信息¹

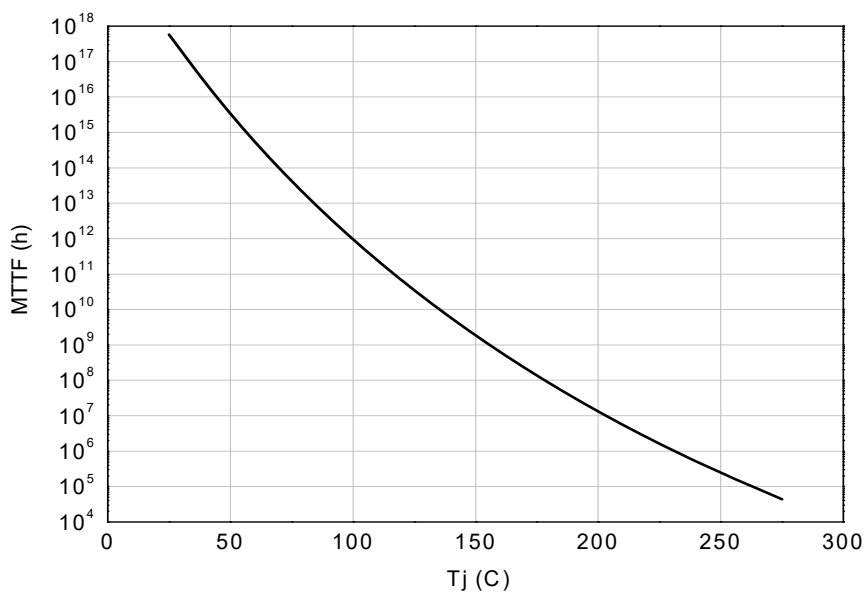
最大输出功率						
频率 (MHz)	源阻抗 Z_s (Ω)	负载阻抗 Z_L (Ω)	功率增益 (dB)	输出功率 (dBm)	输出功率 (W)	漏极效率 (%)
TBD	-	-	-	-	-	-
最大漏极效率						
频率 (MHz)	源阻抗 Z_s (Ω)	负载阻抗 Z_L (Ω)	功率增益 (dB)	输出功率 (dBm)	输出功率 (W)	漏极效率 (%)
TBD	-	-	-	-	-	-

¹ 测试条件: $V_{DS} = 50\text{ V}$, $I_{DQ} = 600\text{ mA}$, 脉宽 $100\ \mu\text{s}$, 占空比 10%。



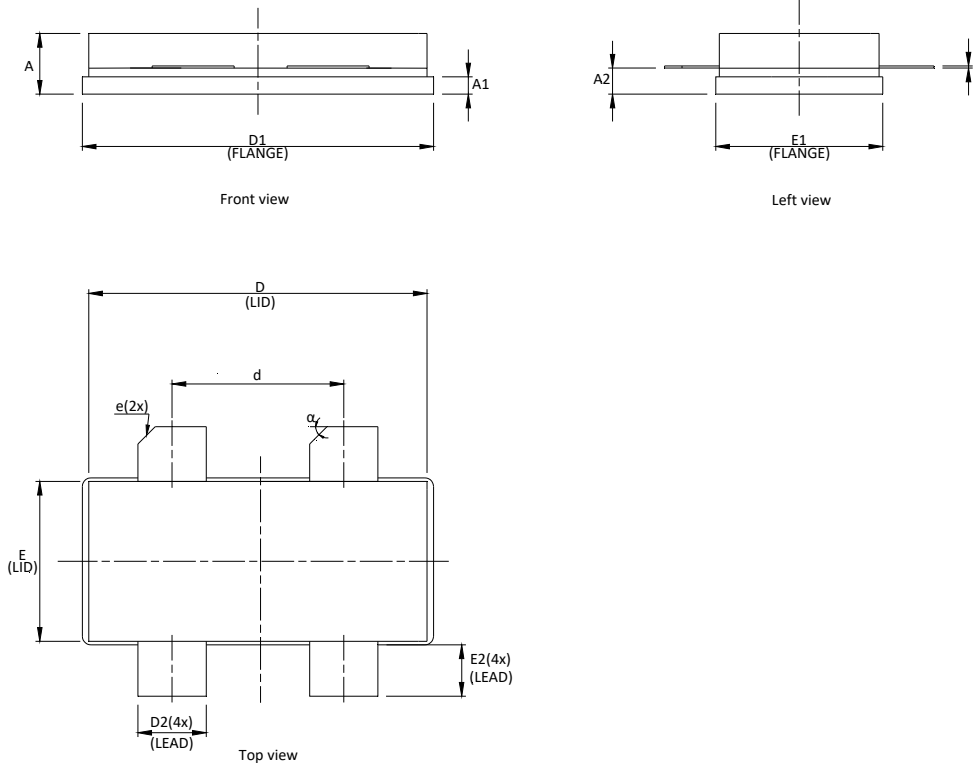
晶体管阻抗定义

6. 可靠性



MTTF 随沟道温度变化曲线

7. 封装尺寸——780P2GB



序号	英寸			毫米		
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
A	0.134	0.144	0.154	3.40	3.65	3.90
A1	0.035	0.040	0.045	0.89	1.02	1.14
A2	0.057	0.062	0.067	1.45	1.58	1.70
D1	0.805	0.810	0.815	20.45	20.58	20.70
D2	0.153	0.158	0.162	3.87	4.00	4.13
d	0.385	0.390	0.395	9.77	9.90	10.03
D	0.772	0.780	0.788	19.61	19.82	20.02
E	0.365	0.370	0.375	9.27	9.40	9.53
E1	0.380	0.385	0.390	9.65	9.78	9.91
E2	0.098	0.118	0.138	2.50	3.00	3.50
F	0.003	0.005	0.006	0.08	0.12	0.15
e	TYP 0.04			TYP 1.02		
α	45° REF			45° REF		

8. 湿敏等级

测试方法	等级
Moisture Sensitivity Level (per J-STD-020)	Level 1

9. 采购信息

产品命名	打标	封装	包装
DF1H0015-900EF	可定制	780P2GB	托盘：一盒 20 Pcs

10. 缩写

缩略语	描述
GaN	氮化镓 (Gallium Nitride)
EMC	电磁兼容 (Electro Magnetic Compatibility)
MTTF	平均失效时间 (Median Time To Failure)
VSWR	电压驻波比 (Voltage Standing Wave Ratio)
TBD	待定 (To Be Determined)